

ВЫСШАЯ ШКОЛА ФИЗИКОВ ИМЕНИ Н.Г. БАСОВА НИЯУ МИФИ

Высшая школа физиков (ВШФ НИЯУ МИФИ) создана как специальный факультет физики в 1971 году при МИФИ и Физическом институте им. П.Н. Лебедева РАН. Основателями ВШФ были лауреат Нобелевской премии академик РАН Н.Г. Басов и профессора В.Г. Кириллов-Угрюмов и Ю.А. Быковский.

ВШФ представляет собой объединение в единое целое трех составляющих: мощной учебно-методической базы (НИЯУ МИФИ), современной научной базы (НИЯУ МИФИ, ФИАН, ИОФАН, РИЦ «Курчатовский институт», ОИЯИ г. Дубна и др.), и способной, легко обучаемой молодежи, которая ежегодно отбирается в ведущих университетах и вузах России и стран СНГ.

ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ

ВШФ осуществляет подготовку специалистов, бакалавров и магистров по специальным образовательным программам элитной инженерно-физической подготовки физико-математического, физико-технического, информационно-профиля для перспективных направлений научных исследований и наукоемких высокотехнологичных отраслей промышленности.

Можно выделить два направления образовательной деятельности ВШФ:

подготовка бакалавров и специалистов высокой квалификации для Российской академии наук, Российских научных центров, исследовательских университетов и вузов России, отраслевых и других организаций, путем конкурсного отбора талантливой молодежи из Москвы, Санкт-Петербурга, и других субъектов Российской Федерации, региональных обособленных подразделений НИЯУ МИФИ и стран СНГ и зачисления в порядке перевода на 6-й учебный семестр для дальнейшего обучения в ВШФ. **Выпускники ВШФ имеют возможность продолжить обучение в магистратуре;**

подготовка магистров из числа выпускников московских и региональных вузов,

обособленных подразделений НИЯУ МИФИ, русскоговорящих выпускников вузов иностранных государств по программам индивидуальной подготовки под руководством крупными учеными, ведущих специалистов, руководителей перспективных научных направлений. **Выпускники имеют возможность продолжить обучение в аспирантуре.**

За время своего существования ВШФ подготовила около 1200 специалистов из более 60 городов России и стран СНГ. Многие выпускники ВШФ возглавляют научные направления во многих региональных научных исследовательских центрах. К ним относятся Самарский филиал ФИАН и научные школы Владивостока, Иркутска, Рязани и др.

Создание и реализация проекта «Высшая школа физиков» отмечены премией Президента РФ в области образования за 2001 год. Высшей школе физиков присвоено имя ее основателя и научного руководителя академика Н.Г. Басова.



О.Н. Крохин,
научный руководитель
Высшей школы физиков
имени Н.Г. Басова,
доктор физико-математических наук,
академик РАН.
И.Н. Завестовская,
и.о. декана,
кандидат физико-математических наук.

ВЫСШИЙ ФИЗИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ

Высший физический колледж Российской академии наук и Федерального агентства по образованию создан в МИФИ в 1991 г. с целью совершенствования высшего физического образования, обеспечения дополнительных условий для развития творческих способностей одаренных студентов и подготовки их для учебы в аспирантуре и последующей научной работы в научно-исследовательских институтах Академии наук и в международных научных центрах.

В состав Попечительского совета колледжа входят академики Е.П. Велихов, Ю.В. Гуляев, И.А. Шербаков, член-корреспондент РАН М.В. Ковальчук — директор Национального исследовательского центра «Курчатовский институт», ученый секретарь Совета по науке, технологиям и образованию при Президенте РФ.

По решению Попечительского совета колледж готовит специалистов в области физики наноструктур и нанотехнологий, физики сверхпроводимости, лазерной физики, взаимодействия концентрированных потоков излучения с веществом, физики, неравновесных твердотельных структур, микро- и нанозлектроники, физики плазмы, микро- и космофизики, релятивистской ядерной физики и по другим приоритетным направлениям физики.

Выбранные направления обеспечивают возможность подготовки специалистов на стыке наук и предусматривают одновременное взаимодействие нескольких выпускающих кафедр и академических институтов.

Обучение ведется по усложненным программам изучения фундаментальных наук — на младших курсах и по индивидуальным планам — на старших. Кроме глубокой подготовки в области физики, математики, теоретической физики большое внимание уделяется компьютерной подготовке, изучению языков и гуманитарным наукам. Традиционно более трети выпускников заканчивают институт с отличием.

Выпускники колледжа отличаются высоким уровнем фундаментальных знаний в математике и физике, а также умением использовать современные наукоемкие и информационные технологии как в фундаментальных, так и в прикладных исследованиях. Колледж имеет свой компьютерный класс, в котором не только проводятся занятия по компьютерному моделированию физических процессов, численным методам в математике и физике, машинной графике, но и предоставляется свободный доступ для работы студентов в сети Интернет во внеучебное время.

Учебно-научной базой колледжа является учебно-научная база НИЯУ МИФИ, а также научных лабораторий академических институтов и НИЦ «Курчатовский институт».

Выпуск специалистов в рамках Высшего физического колледжа осуществляется выпускающими кафедрами: **компьютерного моделирования и физики наноструктур и сверхпроводников** (заведующий кафедрой — ректор НИЯУ МИФИ, д.ф.-м.н.,

профессор М.Н. Стриханов), физики твердого тела и наносистем (и.о. заведующего кафедрой — д.ф.-м.н., профессор А.П. Менушков), лазерной физики (заведующий кафедрой — д.ф.-м.н., профессор Н.Н. Евтихийев), микро- и нанозлектроники (заведующий кафедрой — д.ф.-м.н., профессор В.С. Першенков), физики плазмы (заведующий кафедрой — д.ф.-м.н., профессор В.А. Курнаев), экспериментальной ядерной физики и космофизики (заведующий кафедрой — д.ф.-м.н., профессор В.В. Дмитриенко).



Начиная с третьего курса студенты колледжа занимаются учебно-исследовательской работой, проходят преддипломную практику и дипломное проектирование на базе научных лабораторий институтов — попечителей колледжа: НИЦ «Курчатовский институт», Института общей физики РАН, Физического института РАН, Института радиотехники и электроники РАН, Института кристаллографии РАН, Института физики твердого тела РАН, Физико-технологического института РАН.

Профессора, преподаватели, аспиранты и студенты выполняют совместные научные исследования с рядом зарубежных научных центров и университетов, среди которых Университет г. Гренобля (Франция), Национальный синхротронный центр MAX-lab (Швеция), Научный центр DESY (Германия), Институт Макса Планка (Германия), Университет г. Осло (Норвегия) и др. Многие студенты и выпускники колледжа проходят научную стажировку и с успехом работают в научных центрах и университетах США, Германии, Франции, Англии, Швеции, Италии и Японии.

Выпускники колледжа получают диплом НИЯУ МИФИ и продолжают учебу в аспирантуре НИЯУ МИФИ и академических институтов или научную работу в международных научных центрах.

Набор в Высший физический колледж осуществляется на второй курс из студентов всех дневных факультетов НИЯУ МИФИ после окончания первого курса на конкурсной основе.

Дорогие абитуриенты! Система обучения в Высшем физическом колледже НИЯУ МИФИ позволит развить ваши способности и реализовать ваши творческие возможности. Не упустите свой шанс.

А.П. Менушков,
и.о. декана Высшего физического колледжа,
доктор физико-математических наук,
профессор.

ЦЕНТР ДОВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИ

Основная задача Центра — повышение уровня подготовки будущих студентов НИЯУ МИФИ и создание для них полноценных условий для успешного поступления и обучения в университете.

Структура Центра позволяет реализовать подготовку учащейся молодежи по различным формам, учитывая склонности и возможности потенциальных абитуриентов. Одновременно решается задача подготовки к сдаче единого государственного экзамена (ЕГЭ) и к участию абитуриентов в предметных олимпиадах, проводимых НИЯУ МИФИ.

Дневная очная подготовка реализуется на базе государственных общеобразовательных учебных заведений — лицеев при НИЯУ МИФИ (№1511, №1523 и №1547), школ №985 и №978, в которых обучаются школьники 8–11-х классов по образовательным программам профильного уровня.

Конкурсный отбор учащихся на физико-математическое направление этих учебных заведений проводится ежегодно в марте-апреле в 9-е и 10-е классы и в апреле-мае — в 8-е классы.

По гуманитарному направлению отбор обучающихся в 8-е классы проводится в апреле-мае в лицее №1523.

Занятия по профильным дисциплинам в этих учебных заведениях ведут высокопрофессиональные учителя и преподаватели университета. Выпускники этих учебных заведений получают полное среднее образование и успешно поступают и обучаются в НИЯУ МИФИ.

Вечерняя очная подготовка предлагает обучающимся 28 различных образовательных программ в форме подготовительных курсов.

По физико-математическому и гуманитарному направлениям, включая изучение отдельных дисциплин для подготовки к сдаче ЕГЭ, обучение осуществляется на базе лицеев при НИЯУ МИФИ (для учащихся 7–9-х классов) и университета (для учащихся 10–11-х классов, учащихся колледжей и техникумов), а также на базе ряда школ Москвы и Московской области, имеющих договоры о сотрудничестве с университетом.

Для учащихся 10–11-х классов отдаленных районов Московской области организованы субботние и воскресные лектории.

Занятия проводятся по расписанию и по утвержденному в университете программам. Прием заявлений на обучение по различным программам подготовки производится непрерывно с сентября по март. Обучение платное.

Заочная форма подготовки абитуриентов и школьников 6–11-х классов реализуется Заочной школой НИЯУ МИФИ (сайт www.mifi.ru).

Взаимодействие преподавателей с обучающимися ведется по почтовой или электронной переписке (в зависимости от возможностей обучающихся), что делает доступным обучение для школьников, проживающих в любой точке России.

Приступить к изучению выбранных курсов Заочной школы можно без вступительных экзаменов в течение года в любое время. По каждому предмету выбранного курса обучающийся получает ежегодно обновляемый учебно-методический комплект, разработанный специально для заочной дистанционной формы обучения. Выполненные задания проверяются квалифицированными преподавателями и высылаются в адрес обучающегося вместе с рекомендациями и подробными решениями всех задач. С возникающими вопросами можно также обращаться в консультационный пункт Заочной школы.

Отправлять задания на проверку и получать результаты их проверки можно почтой России или по электронной почте. Работы, отправленные по электронной почте, проверяются с использованием планшета, оснащенного электронным пером.

Более подробная информация о работе Центра довузовской подготовки размещена на сайте www.podfak.mephi.ru.

Телефон для справок: (499) 324-60-40.



В.М. Кирюхин,
начальник Центра
дovuзовской подготовки.

ФАКУЛЬТЕТ ОЧНО-ЗАОЧНОГО (ВЕЧЕРНЕГО) ОБУЧЕНИЯ

Более шестидесяти лет в нашем вузе осуществляется подготовка специалистов для научных учреждений, производственных предприятий и организаций различных ведомств, в том числе для атомной отрасли, по очно-заочной форме обучения. Предлагается, что эта форма обучения, более известная как вечерняя, является оптимальной для людей, занятых работой на производстве. Впервые, такое обучение дает возможность получения престижного образования по новейшим направлениям науки и техники без отрыва от трудовой деятельности, что особенно ценно в нынешних условиях. Во-вторых, облегчается задача адаптации выпускника вуза к профессиональной деятельности.

Особенно ярко преимущества этой формы обучения проявляются, если обучаемый работает по профилю избранной специальности. В этом случае студент и как личность, и как профессионал формируется значительно быстрее. Лучшим подтверждением высокого качества профессиональной подготовки по очно-заочной форме служат результаты карьерного роста выпускников. Среди выпускников вечернего факультета — ныне доктора и кандидаты наук, руководители предприятий и организаций, начальники крупных подразделений.

Пример студентов на первый курс факультета в 2012 году будет осуществляться по четырем направлениям и одной специальности:

- Информатика и вычислительная техника (программа подготовки — вычислительные машины, комплексы, системы и сети);
 - Информационная безопасность (программа подготовки — комплексная защита объектов информатизации);
 - Прикладная информатика (программа подготовки — прикладная информатика в экономике предприятия);
 - Ядерная физика и технологии (программы подготовки — физика конденсированного состояния вещества, электроника и автоматика физических установок, ядерные реакторы и энергетические установки);
 - Электроника и автоматика физических установок (специализация — электроника физических установок).
- За время учебы студенты получают фундаментальную физико-математическую подготовку, овладевают компьютерными и общинженерными знаниями, изучают широкий круг гуманитарных и экономических дисциплин, осваивают профильные дисциплины. Полученные по окончании обучения квалификации бакалавра или инженера-физика позволяют выпускникам факультета успешно работать как в избранных направлениях деятельности, так и в смежных областях науки и техники.
- Продолжительность обучения в бакалавриате лиц, имеющих среднее (полное) образование и желающих

специализироваться по направлениям: информационная безопасность, прикладная информатика, ядерная физика и технологии, равна 5 годам. Срок подготовки инженеров-физиков по специальности «Электроника и автоматика физических установок» — 6 лет.

Выпускники техникумов и колледжей, получившие подготовку по вычислительной технике, информатике, программированию, электронике, микроэлектронике и радиотехнике зачисляются в группы с сокращенным сроком обучения (3,5 года) при условии поступления на родственный профиль. Так, выпускникам колледжей компьютерного профиля предлагается ускоренная подготовка по направлению «Информатика и вычислительная техника» на кафедре компьютерных систем и технологий.

Для выпускников колледжей информационно-экономической направленности кафедрой системного анализа организовано обучение в сокращенные сроки по профилю «Прикладная информатика в экономике предприятия». Помимо базовой подготовки в области информационных и компьютерных технологий студенты изучают широкий комплекс дисциплин, связанных с маркетингом, менеджментом, рыночной экономикой и предпринимательской деятельностью.

Выпускники колледжей, специализирующиеся в области электроники, микроэлектроники и радиотехники, могут обучаться на кафедрах электрофизических установок и микро- и нанозлектроники в течение трех с половиной лет по профилю «Электроника и автоматика физических установок».

Обучение студентов на факультете осуществляется как за счет средств федерального бюджета для прошедших конкурсный отбор по результатам вступительных испытаний, так и на платной (контрактной) основе. На факультете возможно получение второго высшего образования по перечисленным направлениям и профилям (сроки обучения: 2-4 года в зависимости от вида и уровня предыдущего образования).

Принимаются на факультет очно-заочного (вечернего) обучения лица со средним, средним профессиональным или с высшим образованием, проживающие в Москве или в Московской области.

Дополнительные сведения о порядке приема на факультет можно получить по телефонам: (499) 324-71-04, (499) 323-95-08.

Б.Ф. Ануфриев, декан факультета
очно-заочного (вечернего) обучения.

